

半導体ナノテクノロジー基礎論

2 単位 (選択 (B))

Introduction to Semiconductor Nanotechnology

井須 俊郎・教授 / 大学院ソシオテクノサイエンス研究部, 北田 貴弘・准教授 / 大学院ソシオテクノサイエンス研究部

【授業目的】半導体エレクトロニクスの先端分野で用いられているナノテクノロジーについて基礎的な概念を理解する。

【授業概要】半導体のナノ構造が生み出す性質を理解するための基礎知識として、半導体の電気的特性、ナノ構造における量子力学的効果など、半導体ナノ構造の特徴について説明する。これらの半導体ナノ構造を用いた各種の電子デバイス、光デバイスについて概説し、さらに半導体ナノ構造の作製の手法とそれらの構造や特性の測定評価方法について解説する。

【キーワード】ナノ量子構造, 半導体ナノ物性, 電子デバイス, 光デバイス

【関連科目】『光・電子物性工学1』(0.5), 『光デバイス1』(0.5)

【履修要件】特になし。

【履修上の注意】量子力学を履修していることが望ましい。

【到達目標】半導体ナノ構造の特徴と応用例について理解する。

【授業計画】

1. 半導体ナノ構造とは
2. 半導体の性質
3. 電子状態の量子化
4. 低次元量子構造
5. 半導体ナノ構造の光物性
6. 光デバイス応用 (受光発光素子)
7. 光デバイス応用 (光制御素子)
8. 半導体ナノ構造の電子物性
9. 電子デバイス応用 (HBT)
10. 電子デバイス応用 (FET)
11. 結晶成長法による形成技術
12. 微細加工による形成技術
13. ナノ構造測定手法
14. 電気的特性評価
15. 光学的特性評価
16. 期末試験

【成績評価基準】レポート (60%), 試験 (40%)

【教科書】特になし。

【参考書】「半導体超格子の物理と応用」日本物理学会編, 培風館

【授業コンテンツ】 <http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/cgi-bin/toURL?EID=216267>

【対象学生】関心のある学生は誰でも受講可。

【連絡先】

⇒ 井須 (A224, 088-656-7670, t.isu@frc.tokushima-u.ac.jp) MAIL (オフィスアワー: 火曜日-木曜日 10:00-14:00)

⇒ 北田 (A224, 088-656-7671, kitada@frc.tokushima-u.ac.jp) MAIL (オフィスアワー: 月曜日 10:00-14:00)